

실험 12 공통드레인 증폭기

- 이름 :
- 실험일 :

시뮬레이션 12-1 | N-채널 MOSFET 공통드레인 증폭기 해석하기

표 12-1 N-채널 MOSFET 공통드레인 증폭기의 시뮬레이션 결과

동작점 전류, 전압 (시뮬레이션 결과)	V_{GQ} [V]	
	V_{SQ} [V]	
	V_{GSQ} [V]	
	I_{DQ} [mA]	
	V_{DSQ} [V]	
전달컨덕턴스 계산 (시뮬레이션 결과)	$g_m = \frac{2I_{DQ}}{V_{GSQ} - V_{Tn}} \text{ [mA/V]}$ V_{Tn} 은 실험 09의 시뮬레이션 결과 값을 사용	
v_s 와 v_o 의 위상 관계		
v_s 의 첨두-첨두값 [V] (시뮬레이션 입력)		
v_o 의 첨두-첨두값 [V] (시뮬레이션 결과)		

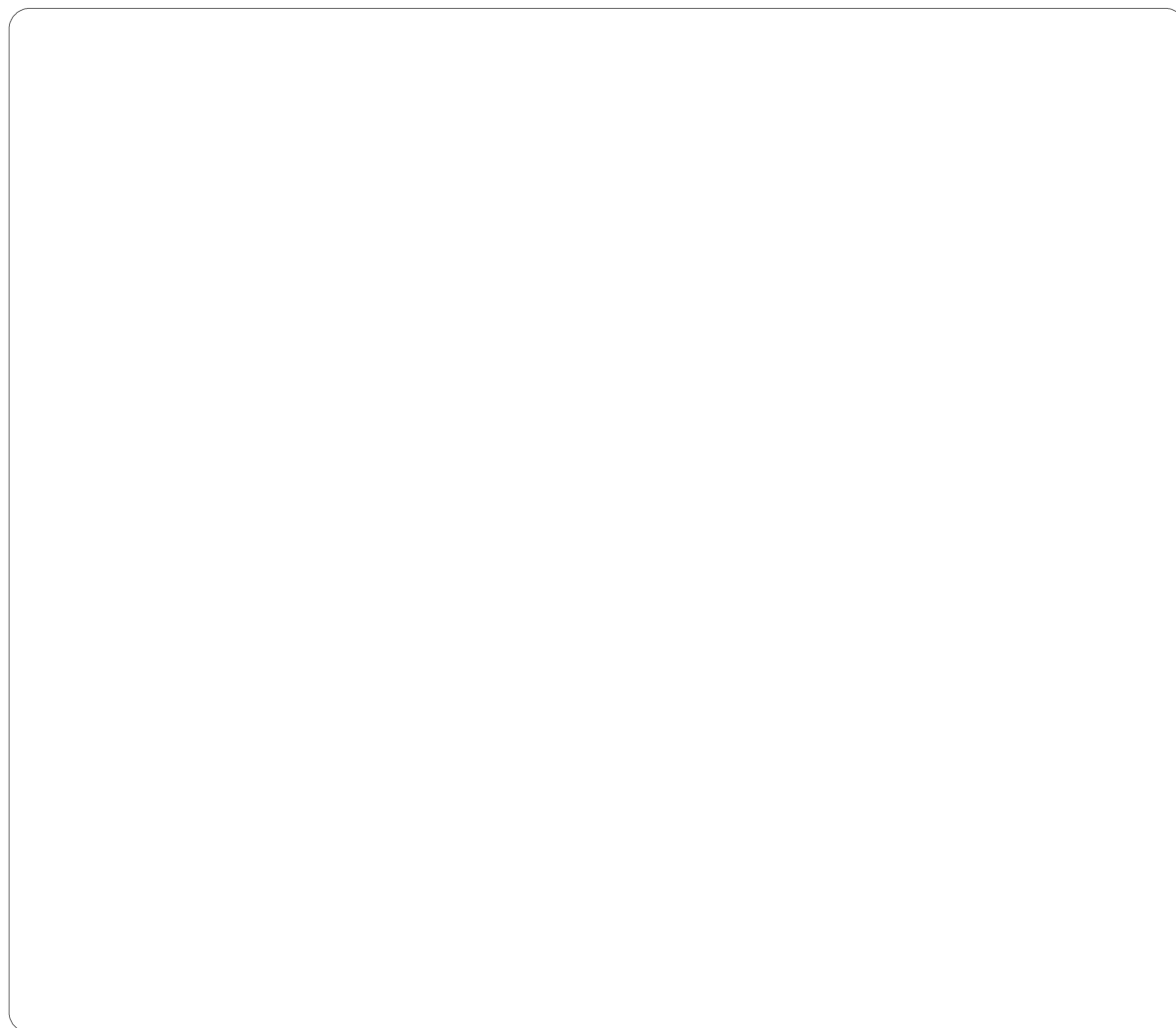


그림 12-4 N-채널 MOSFET 공통드레인 증폭기의 시뮬레이션 결과 파형

시뮬레이션 회로

■ 시뮬레이션 12-1-1 회로



■ 시뮬레이션 12-1-2 회로

